

JAPAN PATENT OFFICE

Jc760 U.S. PRO
10/014949
10/26/01

This is to certify that the annexed is a true copy of following application
as filed with this Office.

#2 *Priority
paper
3-5-02
rests*

Date of Application: April 25, 2001

Application Number: P2001-128187

Applicant(s): Sanken Electric Co., Ltd.

June 12, 2001

Commissioner,
Japan Patent Office

Kouzou OIKAWA

Number of Certification: 2001-3055149

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

1c760 U.S. PTO
10/014949
10/26/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 4月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-128187

出 願 人

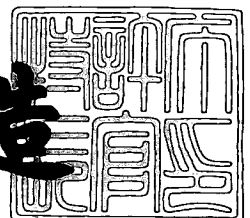
Applicant(s):

サンケン電気株式会社

2001年 6月12日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3055149

【書類名】 特許願

【整理番号】 SNK-99

【提出日】 平成13年 4月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 27/06

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社
社内

 【氏名】 山本 誠

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社
社内

 【氏名】 岩渕 昭夫

【特許出願人】

 【識別番号】 000106276

 【氏名又は名称】 サンケン電気株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100083806

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三好 秀和

 【電話番号】 03-3504-3075

【選任した代理人】

 【識別番号】 100068342

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

 【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100079946

【弁理士】

【氏名又は名称】 横屋 赳夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9803324

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 導電型の半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された第 2 導電型の第 1 埋込領域と、
該第 1 埋込領域の上部に形成された前記第 2 導電型の一様ベース領域と、
該一様ベース領域の表面から前記埋込領域に到達するように形成された第 2 導電型の第 1 プラグと、
前記一様ベース領域内に形成された前記第 1 導電型の第 1 及び第 2 主電極領域と、
前記一様ベース領域内に前記第 1 主電極領域の底部及び側面を包囲するように形成され不純物密度が前記第 1 主電極領域から前記第 2 主電極領域に向かって低下するプロファイルを有する前記第 2 導電型の勾配ベース領域
とを有する第 1 のトランジスタを具備し、前記一様ベース領域と前記勾配ベース領域とで前記第 1 のトランジスタの第 1 ベース領域を構成することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 前記半導体基板上に形成された前記第 2 導電型の第 2 埋込領域からなる第 3 主電極領域と、
前記第 2 埋込領域の上部に形成された前記第 2 導電型のドリフト領域と、
該ドリフト領域内に形成された前記第 1 導電型の第 2 ベース領域と、
前記第 2 ベース領域内に形成された前記第 2 導電型の第 4 主電極領域とを有する第 2 のトランジスタとを更に具備することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 3】 第 1 導電型の半導体基板上に第 2 導電型の第 1 拡散領域を形成する工程と、
該第 1 拡散領域の上部に前記第 2 導電型のエピタキシャル成長層を形成し前記第 1 拡散領域を第 1 埋込領域とする工程と、
前記第 1 埋込領域に到達するように前記エピタキシャル成長層の表面から前記第 2 導電型の第 1 プラグを形成する工程と、

前記エピタキシャル成長層の表面から前記第 1 プラグ及び前記第 1 埋込領域と離間して前記第 2 導電型の勾配ベース領域を熱拡散により形成する工程と、

前記勾配ベース領域内に前記第 1 導電型の第 1 主電極領域を形成する工程と、
前記エピタキシャル成長層の表面に前記第 1 主電極領域から離間して前記第 1 導電型の第 2 主電極領域を形成する工程

とを具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 4】 前記エピタキシャル成長の前に、前記半導体基板上に前記第 2 導電型の第 2 拡散領域を更に形成する工程を更に具備し、

前記エピタキシャル成長により前記第 2 拡散領域を第 3 主電極領域となる第 2 埋込領域とすることを特徴とする請求項 3 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 5】 前記エピタキシャル成長層内の前記第 2 埋込領域の上部に前記第 1 導電型の第 2 ベース領域を形成する工程と、

該第 2 ベース領域内に前記第 2 導電型の第 4 主電極領域を形成する工程

とを更に具備することを特徴とする請求項 4 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 6】 前記勾配ベース領域と前記第 1 主電極領域とを同一拡散窓を用いて形成することを特徴とする請求項 3 ～ 5 のいずれか 1 項記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する分野】

本発明は、半導体装置に係り、特に半導体基板上にモノリシックに集積化するのに好適な横型トランジスタの構造に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

半導体集積回路の一つとし、電力用トランジスタとこれを制御する制御回路とを同一半導体チップに搭載した構造が知られている。このようなパワー IC においては、電力用トランジスタを縦型 npn トランジスタにより構成し、制御回路は、比較的小電力のトランジスタである横型 pnp トランジスタで構成する場合がある。このような半導体集積回路（パワー IC）における従来の横型 pnp ト

ランジスタは、例えば、図8に示すように構成されている。即ち、従来の横型 p n p トランジスタは、半導体基板 1、半導体基板 1 上に形成された n 型の第 1 埋込領域 2 2、半導体基板 1 の表面全体に亘って形成された n 型の第 1 ベース領域 3 3、第 1 埋込領域 2 2 に到達するように形成された n 型の第 1 プラグ、第 1 ベース領域 3 3 内に形成された p 型の第 1 エミッタ領域 6 及び第 1 コレクタ領域 7、第 1 プラグ内に形成された n 型の第 1 ベースコンタクト領域 9 とを有している。このように構成された横型 p n p トランジスタは、更に、その表面のフィールド絶縁膜 8 6 と、フィールド絶縁膜 8 6 に形成されたコンタクトホールを介して第 1 エミッタ配線 1 1、接続配線 1 2、第 1 ベース配線 1 4 とが形成されている。接続配線 1 2 は第 1 コレクタ配線として機能し、図示を省略した高耐圧の縦型 n p n トランジスタのベース電極に接続されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上述したような従来の半導体集積回路においては、横型 p n p トランジスタの第 1 ベース領域 3 3 と高耐圧の縦型 n p n トランジスタのドリフト領域（コレクタ領域）とを同一のエピタキシャル成長層で構成するのが、製造プロセス上、好都合である。即ち、図示を省略しているが、図 8（a）の断面の奥に第 2 エミッタ領域、第 2 ベース領域、第 2 コレクタ領域とからなる縦型 n p n トランジスタが構成される。この場合、縦型 n p n トランジスタの耐圧の要求から、横型 p n p トランジスタの第 1 ベース領域 3 3 の不純物密度は比較的 low に設定せざるを得ない。このため、横型 p n p トランジスタのコレクター-エミッタ間耐圧（ BV_{ce} ）を確保するためには、ベース幅 W_b を相対的に広くする必要がある。

【0004】

しかしながら、ベース幅 W_b を広くすると、横型 p n p トランジスタの電流増幅率が低下し、特性低下を招く。更に、横型 p n p トランジスタの占有スペースの増大を招き、結果として半導体素子の集積度を低下することとなり好ましくない。

【0005】

本発明は上述の如き従来の課題を解決するためになされたもので、その目的は

、従来の横型バイポーラトランジスタ（BJT）に比較してベース幅 W_b を狭くして所望のコレクターエミッタ間耐圧（ BV_{ceo} ）を得ることが出来る半導体装置及びその製造方法を提供することである。

【 0 0 0 6 】

本発明の他の目的は、横型BJTの占有スペースを減少することが出来、集積度を高めることが出来る半導体装置及びその製造方法を提供することである。

【 0 0 0 7 】

本発明の更に他の目的は、集積化されたBJTの電流増幅率を向上させることが出来る半導体装置及びその製造方法を提供することである。

【 0 0 0 8 】

本発明の更に他の目的は、従来の半導体装置の製造方法に比べ簡略なプロセスで高集積化されたBJTの形成が可能になり、大幅なコストダウンが実現できる半導体装置及びその製造方法を提供することである。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の第1の特徴は、第1導電型の半導体基板と、半導体基板上に形成された第2導電型の第1埋込領域、第1埋込領域の上部に形成された第2導電型の一様ベース領域、一様ベース領域の表面から埋込領域に到達するように形成された第2導電型の第1プラグ、一様ベース領域内に形成された第1導電型の第1及び第2主電極領域、一様ベース領域内に第1主電極領域の底部及び側面を包囲するように形成され不純物密度が第1主電極領域から第2主電極領域に向かって低下するプロファイルを有する第2導電型の勾配ベース領域とを有する第1のトランジスタを具備する半導体装置であることである。ここで、一様ベース領域と勾配ベース領域とで第1のトランジスタの第1ベース領域を構成する。「第1導電型」と「第2導電型」とは互いに反対導電型である。即ち、第1導電型がn型であれば、第2導電型はp型であり、第1導電型がp型であれば、第2導電型はn型である。また、「第1主電極領域」とは、バイポーラトランジスタ（BJT）のエミッタ領域又はコレクタ領域のいずれか一方の半導体領域を意味する。「第2主電極領域」とは、上記第1主電極領域とはならな

いエミッタ領域又はコレクタ領域のいずれか一方の半導体領域を意味する。

【 0 0 1 0 】

本発明の第 1 の特徴によれば、第 1 主電極領域を隣接して包囲するように勾配ベース領域を形成することにより、横型 B J T の勾配ベース領域の不純物密度を相対的に増加することが出来るため、従来の横型 B J T に比較して勾配ベース領域の幅 W_b を狭くして所望のコレクターエミッタ間耐圧 ($B V_{ceo}$) を得ることが出来る。また、勾配ベース領域の幅 W_b を狭くすることが出来るため、横型 B J T の占有スペースが減少し、結果として半導体集積回路の集積度を高めることが出来る。更に、勾配ベース領域の幅 W_b を狭くすることが出来ることに加えて、勾配ベース領域の不純物密度を第 1 主電極領域から第 2 主電極領域に向かって徐々に低下する勾配を持たせていることにより最適なドリフト電界が得られ、勾配ベース領域に注入されたキャリアのベース輸送効率の増大し、ベース走行時間の短縮等を図ることが出来る。このため、B J T の電流増幅率が向上する。

【 0 0 1 1 】

本発明の第 1 の特徴において、半導体基板上に形成された第 2 導電型の第 2 埋込領域からなる第 3 主電極領域、第 2 埋込領域の上部に形成された第 2 導電型のドリフト領域、ドリフト領域内に形成された第 1 導電型の第 2 ベース領域、第 2 ベース領域内に形成された第 2 導電型の第 4 主電極領域とを有する第 2 のトランジスタとを更に具備することが可能である。「第 3 主電極領域」とは、B J T のエミッタ領域又はコレクタ領域のいずれか一方の半導体領域を意味する。「第 4 主電極領域」とは、上記第 3 主電極領域とはならないエミッタ領域又はコレクタ領域のいずれか一方の半導体領域を意味する。

【 0 0 1 2 】

本発明の第 2 の特徴は、(イ) 第 1 導電型の半導体基板上に第 2 導電型の第 1 拡散領域を形成する工程、(ロ) 第 1 拡散領域の上部に第 2 導電型のエピタキシャル成長層を形成し第 1 拡散領域を第 1 埋込領域とする工程、(ハ) 第 1 埋込領域に到達するようにエピタキシャル成長層の表面から第 2 導電型の第 1 プラグを形成する工程、(ニ) エピタキシャル成長層の表面から第 1 プラグ及び第 1 埋込領域と離間して第 2 導電型の勾配ベース領域を熱拡散により形成する工程、(ホ

）勾配ベース領域内に第 1 導電型の第 1 主電極領域を形成する工程、（へ）エピタキシャル成長層の表面に第 1 主電極領域から離間して第 1 導電型の第 2 主電極領域を形成する工程を具備する半導体装置の製造方法であることである。

【 0 0 1 3 】

本発明の第 2 の特徴によれば、先に形成した勾配ベース領域は第 1 主電極領域形成時に、第 1 主電極領域よりも深くドライブインされることから、勾配ベース領域は第 1 主電極領域を隣接して包囲するように形成される。そして、勾配ベース領域と第 1 主電極領域とを同一拡散窓を使用して自己整合的に D S A (Diffusion Self Alignment) によって形成することが可能であるため、第 1 主電極領域の縁部から横方向に延びる勾配ベース領域の広がり幅は両方向で等しく、かつ不純物プロファイルの勾配も等しくすることが出来る。平面パターン上勾配ベース領域が第 1 主電極領域を囲むように環状に形成される場合は、環状の勾配ベース領域の幅が一定に形成できる。このため、従来の半導体装置の製造方法に比べ簡略なプロセスで高集積化された B J T の形成が可能になり、大幅なコストダウンが実現できる。なお、「拡散窓」とは、プレデポジション（気相拡散）に用いる酸化膜中に設けられた窓でも良く、イオン注入に用いるレジスト膜中に設けられた窓でも構わない。

【 0 0 1 4 】

本発明の第 2 の特徴に係る半導体装置の製造方法において、エピタキシャル成長の前に半導体基板上に第 2 導電型の第 2 拡散領域を更に形成し、エピタキシャル成長により第 2 拡散領域を第 3 主電極領域となる第 2 埋込領域とすることが可能である。また、本発明の第 2 の特徴に係る半導体装置の製造方法において、エピタキシャル成長層内の第 2 埋込領域の上部に第 1 導電型の第 2 ベース領域を形成し、第 2 ベース領域内に第 2 導電型の第 4 主電極領域を形成することが可能である。

【 0 0 1 5 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号が付してある。

【 0 0 1 6 】

(半導体装置の構成)

図 1 (a) に示すように、本発明の実施の形態に係る半導体装置は、縦型 $n p n$ トランジスタ ($B J T$) $Q 2$ のベース電極に、横型 $p n p$ トランジスタ ($B J T$) $Q 1$ のコレクタ電極が接続されている。縦型 $n p n$ トランジスタ ($B J T$) $Q 2$ のコレクタ電極は、負荷 R_{L2} を介して電源線 V_{cc} に接続されている。

【 0 0 1 7 】

横型 $p n p$ トランジスタ ($B J T$) $Q 1$ のコレクタ電極は、負荷 R_{L1} を介して電源線 V_{cc} に接続されている。図 1 (b) は、図 1 (a) の等価回路に対応した平面図を示すものである。

【 0 0 1 8 】

図 1 (a) 、 (b) に示すように、本発明の実施の形態に係る半導体装置は、電力用トランジスタを縦型 $n p n$ トランジスタ ($B J T$) $Q 2$ により構成し、これを制御する比較的小電力のトランジスタを横型 $p n p$ トランジスタ ($B J T$) $Q 1$ で構成し、双方のトランジスタを同一半導体基板上にモノリシックに集積化した半導体集積回路 (パワー $I C$) である。従って、図 1 (b) に示すように、平面パターン上、横型 $p n p$ トランジスタ (第 1 のトランジスタ) $Q 1$ が形成された領域とは別の領域には、縦型 $n p n$ トランジスタ (第 2 のトランジスタ) $Q 2$ がモノリシックに集積化されている。

【 0 0 1 9 】

横型 $p n p$ トランジスタは、図 1 (b) 及び図 2 (a) に示すように、 p 型 (第 1 導電型) の半導体基板 1 、半導体基板 1 上に形成された n 型 (第 2 導電型) の第 1 埋込領域 2 2 、半導体基板 1 の表面全体に亘って形成された n 型の一様ベース領域 3 1 、第 1 埋込領域 2 2 に到達するように形成された n 型の第 1 プラグ領域 4 、一様ベース領域 3 1 内に形成された p 型の第 1 エミッタ領域 (第 1 主電極領域) 6 及び第 1 コレクタ領域 (第 2 主電極領域) 7 、一様ベース領域 3 1 内に第 1 エミッタ領域 6 を包囲するように形成された勾配ベース領域 5 、第 1 プラグ領域 4 内に形成された第 1 ベースコンタクト領域 9 とを有している。半導体基板 1 としてはシリコン ($S i$) 基板が使用可能である。横型 $p n p$ トランジスタ

は、素子分離領域49により周囲を囲まれ、他の半導体素子と分離されている。素子分離領域49は半導体基板1に到達するように形成された素子分離溝の溝面を覆う溝面絶縁膜92及び溝面絶縁膜92上に形成される埋込絶縁膜91から構成されている。

【0020】

横型pnpトランジスタの表面にはフィールド絶縁膜86が形成されている。このフィールド絶縁膜86中に形成されたコンタクトホールを介してアルミニウム合金膜からなる第1エミッタ配線11が第1エミッタ領域6に、接続配線12が第1コレクタ領域7に、第1ベース配線14が第1ベースコンタクト領域9に接続されている。接続配線12は第1コレクタ配線として機能し、縦型npnトランジスタの第2ベースコンタクト領域に接続されている。アルミニウム合金膜としては、例えばAl-Si又はAl-Cu-Si膜等が使用可能である。

【0021】

縦型npnトランジスタは、図2(b)に示すように、p型の半導体基板1、半導体基板1上に形成されたn型の第2埋込領域(第3主電極領域)23、半導体基板1の表面全体に亘って形成されたn型のドリフト領域32、第2埋込領域23に到達するように形成されたn型の第2プラグ領域43、ドリフト領域32内に形成されたp型の第2ベース領域35、第2ベース領域35内に形成されたn型の第2エミッタ領域(第4主電極領域)36及びp型の第2ベースコンタクト領域39、第2プラグ領域4内に形成された第2コレクタコンタクト領域44とを有している。横型pnpトランジスタと同様に溝面絶縁膜92及び溝面絶縁膜92上に形成される埋込絶縁膜91からなる素子分離領域49により周囲を囲まれている。この縦型npnトランジスタの表面には横型pnpトランジスタと同様にフィールド絶縁膜86が形成されている。フィールド絶縁膜86中に形成されたコンタクトホールを介してアルミニウム合金膜からなる第2エミッタ配線42が第2エミッタ領域36に、横型pnpトランジスタの第1コレクタ領域7から延長形成された接続配線12が第2ベースコンタクト領域39に、第2コレクタ配線41が第2コレクタコンタクト領域44に接続されている。

【0022】

本発明の実施の形態に係る半導体集積回路では、横型 p n p トランジスタの p 型の第 1 エミッタ領域 6 を隣接して包囲するように n 型の勾配ベース領域 5 を形成し、第 1 エミッタ領域 6 から第 1 コレクタ領域 7 との間に介在する勾配ベース領域 5 の不純物プロファイルの勾配を第 1 エミッタ領域 6 から第 1 コレクタ領域 7 に向かって徐々に低下するように形成される。第 1 エミッタ領域 6 を隣接して包囲するように勾配ベース領域 5 を形成することにより、横型 p n p トランジスタの勾配ベース領域 5 の不純物密度を、一様ベース領域 3 1 の不純物密度に比し相対的に増加することが出来る。このため、従来の横型 p n p トランジスタに比較してベース幅 W_b を狭くして所望のコレクターエミッタ間耐圧 ($B V_{ceo}$) を得ることが出来る。また、本発明の実施の形態に係る半導体集積回路では、ベース幅 W_b を狭くすることが出来るため、横型 p n p トランジスタの占有スペースが減少し、結果として、半導体集積回路の集積度を高めることが出来る。更に、ベース幅 W_b を狭くすることが出来ることに加え、勾配ベース領域 5 の不純物密度を第 1 エミッタ領域 6 から第 1 コレクタ領域 7 に向かって徐々に低下する勾配を持たせていることにより、最適なドリフト電界が得られ、第 1 ベース領域 3 に注入されたキャリアのベース輸送効率の増大、ベース走行時間の短縮等を図ることが出来、電流増幅率が向上する。

【 0 0 2 3 】

(半導体装置の製造工程)

次に、本発明の実施の形態に係る半導体装置（半導体集積回路）の製造方法について、図 3 乃至図 7 を参照して説明する。

【 0 0 2 4 】

(イ) まず、図 3 (a) に示すように p 型の S i 基板からなる半導体基板 1 を用意し、図 3 (b) に示すように、この半導体基板 1 の主面に 3 0 0 n m ~ 6 0 0 n m の酸化膜 8 1 を熱酸化により形成する。この後、フォトリソグラフィ技術により酸化膜 8 1 をパターニングして、図 3 (c) に示すように、n 型の第 1 埋込領域及び第 2 埋込領域を形成するための拡散窓を開口する。この酸化膜 8 1 をイオン注入用マスクとして用いて n 型不純物イオン（例えば $^{31}P^+$ など）をイオン注入し、その後活性化アニールをすることにより、図 3 (d) に示すよう

に第1埋込領域用の n^+ 拡散領域21及び紙面の奥に位置するため図示を省略した第2埋込領域用の n^+ 拡散領域を形成する。

【0025】

(ロ) 次に、表面の酸化膜81を除去し、図3(e)に示すように、 n^+ 拡散領域21の上に n 型のエピタキシャル成長層34を $5\mu m \sim 50\mu m$ 堆積する。エピタキシャル成長中の n 型不純物のオートドーピング及び上方拡散により、エピタキシャル成長層34と半導体基板1との界面に第1埋込領域22が形成される。第1埋込領域22の上部のエピタキシャル成長層34は横型 pnp トランジスタの一樣ベース領域31として機能する。一方、図示を省略した n^+ 拡散領域型にも第2埋込領域がエピタキシャル成長層34と半導体基板1との界面に形成される。第2埋込領域23上に形成されたエピタキシャル成長層34は、縦型 nnp トランジスタのドリフト領域32として機能する。

【0026】

(ハ) 次に、エピタキシャル成長層34(31, 32)の表面に $500nm \sim 1\mu m$ の酸化膜82を熱酸化により形成する。そして、リソグラフィ工程により形成したレジスト膜をマスクとして反応性イオンエッチング(RIE)法等によるエッチングにより酸化膜82を選択的にエッチングし、図4(f)に示すように、素子分離溝形成予定領域を開口した酸化膜82からなるエッチングマスクを形成する。このエッチングマスク82を用いて、RIE法等により、半導体基板1が露出するまで、U溝(トレンチ)からなる素子分離溝71を形成する。この素子分離溝71は、一樣ベース領域31及びドリフト領域32をそれぞれ囲むようにエピタキシャル成長層34の表面から半導体基板1に向かって形成される。次に、酸化膜82を除去した後、この素子分離溝71の表面を $100nm \sim 500nm$ 熱酸化し、溝面絶縁膜92を形成する。更に図4(g)に示すように、CVD法により多結晶シリコンからなる埋込絶縁膜91を溝面絶縁膜92の上に形成し、素子分離溝71を埋め込む。

【0027】

(ニ) 次に、図4(h)に示すように、化学的機械研磨(CMP)等を用いて、エピタキシャル成長層34の表面が露出するまで平坦化し、素子分離溝71の

内部にのみ溝面絶縁膜 9 1 及び埋込絶縁膜 9 1 を埋め込み素子分離領域を完成させる。その後、図 5 (i) に示すように、エピタキシャル成長層 3 4 (一様ベース領域 3 1) の表面にフィールド酸化膜となる新たな酸化膜 8 6 を厚さ 3 0 0 n m ~ 6 0 0 n m 程度で形成する。そして、酸化膜 8 6 をフォトリソグラフィ技術を用いてパターンニングし、第 1 プラグ領域及び第 2 プラグ領域に対応した拡散窓を開口する。この拡散窓を介して n 型不純物イオンを注入し、その後、不活性ガス中で活性化アニールとドライブインアニールをして、図 5 (j) に示すように第 1 プラグ領域 4 を形成する。図 5 (j) において図示を省略しているが、紙面の奥の方には第 2 プラグ領域 4 3 が形成される。ここで、不活性ガスとは窒素 (N_2)、アルゴン (Ar)、ヘリウム (He) 等を意味する。更に、これらの不活性ガス中に微量の酸素 (O_2) を含んでも良い。なお、本明細書中では、微量の酸素を含む場合を含めて「不活性ガス中で」と略記する。

【 0 0 2 8 】

(ホ) 次に、図 5 (k) に示すように、表面の酸化膜 8 6 の表面にレジスト膜 5 1 を形成した後、フォトリソグラフィ技術を用いて、レジスト膜 5 1 の第 1 エミッタ領域形成予定領域に拡散窓を開口する。更に、レジスト膜 5 1 をマスクとして酸化膜 8 6 を R I E 法等でエッチングしてエピタキシャル成長層 3 4 (一様ベース領域 3 1) の表面を露出させる。このレジスト膜 5 1 及び酸化膜 8 6 を注入マスクとして n 型不純物イオンを選択的に注入する。レジスト膜 5 1 除去後、更に新たなレジスト膜を塗布し、このレジスト膜に対しフォトリソグラフィ技術を用いて、第 1 エミッタ領域の上部を覆い、p 型の第 2 ベース領域形成予定領域に拡散窓を開口する。第 2 ベース領域形成予定領域は紙面の奥に位置し図示されない。このレジスト膜をマスクとして酸化膜 8 6 をエッチングしてドリフト領域 3 2 の表面を露出させる。そして、このレジスト膜及び酸化膜 8 6 を注入マスクとして、p 型不純物イオンを選択的に注入する。レジスト膜除去後、不活性ガス中でアニールし、図 6 (1) に示すように n 型の勾配ベース領域 5 を形成する。一方、このアニールにより縦型 n p n トランジスタ形成領域においては、p 型の第 2 ベース領域 3 5 が形成される (図 6 (1) では紙面の奥に位置するので図示されない。) 。

【 0 0 2 9 】

(へ) 更に、図 6 (m) に示すように、酸化膜 8 6 の上に更に新たなレジスト膜 5 2 を塗布し、フォトリソグラフィ技術を用いて、このレジスト膜 5 2 の第 1 エミッタ領域形成予定領域、第 1 コレクタ領域形成予定領域、第 2 ベースコンタクト領域形成予定領域に対して開口部を形成する。第 2 ベースコンタクト領域形成予定領域は紙面の奥に位置するため図示されない。更にレジスト膜 5 2 をマスクとして、R I E 法等でエッチングし、エピタキシャル成長層 3 4 の表面を選択的に露出する。この開口部を有するレジスト膜 5 2 を注入マスクとして p 型の不純物イオン (例えば $^{11}\text{B}^+$ など) を図 6 (m) に示すように、選択的にイオン注入する。

【 0 0 3 0 】

(ト) 次に、レジスト膜 5 2 を除去し、新たなレジスト膜を全面に塗布する。この新たなレジスト膜に対してフォトリソグラフィ技術により第 1 エミッタ領域 6、第 1 コレクタ領域 7、第 2 ベースコンタクト領域 3 9 の上部をカバーし、第 1 ベースコンタクト領域形成予定領域、第 2 エミッタ領域形成予定領域、第 2 コレクタコンタクト領域形成予定領域に拡散窓を開口する。第 2 エミッタ領域形成予定領域、第 2 コレクタコンタクト領域形成予定領域は紙面の奥に位置するため図示されない。第 1 ベースコンタクト領域の開口部は、第 1 プラグ領域 4 の内部に位置するように位置合わせされる。このレジスト膜を注入マスクとして、n 型の不純物イオン (例えば $^{75}\text{As}^+$ など) を選択的にイオン注入する。この後、レジスト膜を除去し、不活性ガス中で活性化アニールをすることにより図 6 (n) に示すように、第 1 エミッタ領域 6、第 1 コレクタ領域 7、第 1 ベースコンタクト領域 9 を形成する。図示を省略しているが、この活性化アニールにより同時に、第 2 ベースコンタクト領域 3 9、第 2 エミッタ領域 3 6、第 2 コレクタコンタクト領域 4 4 も形成される。このとき、先にドライブインされた勾配ベース領域 5 は、第 1 エミッタ領域 6 よりも深くドライブインされる。この結果、勾配ベース領域 5 は、第 1 エミッタ領域 6 を包囲するように形成される。即ち、勾配ベース領域 5 と第 1 エミッタ領域 6 は、第 1 エミッタ領域 6 と勾配ベース領域 5 とを同一の拡散マスクを使用して D S A によって自己整合的に形成するため、第

1 エミッタ領域 6 の縁部から図 6 (n) 中で左右に延びる勾配ベース領域 5 の広がり幅は等しく、かつ左右の方向に測ったそれぞれの不純物プロファイルの勾配も等しくなっている。同様に図示を省略しているが、紙面の垂直方向でも対向する 2 方向の勾配ベース領域 5 の広がり幅は等しくなる。更に、本発明の実施の形態においては、平面パターン上において勾配ベース領域 5 の端部が横方向拡散により第 1 コレクタ領域 7 の端部に到達するように拡散深さが制御される。ただし、勾配ベース領域 5 は必ずしも第 1 コレクタ領域 7 に到達する必要はない。

【 0 0 3 1 】

(チ) 第 1 エミッタ領域 6、第 1 コレクタ領域 7、第 1 ベースコンタクト領域 9、第 2 ベースコンタクト領域 3 9、第 2 エミッタ領域 3 6、第 2 コレクタコンタクト領域 4 4 等を形成する際に不活性ガス中でアニールすることにより、イオン注入用の窓として用いたそれぞれの拡散窓は、メタライゼーション用のコンタクト窓としてそのまま利用することが可能である。即ち、これらの領域 6、7、9、3 9、3 6、4 4 等を形成する際に拡散窓に露出したエピタキシャル成長層 3 4 の表面には酸化膜が形成されない。微量の酸素を含む雰囲気の場合は薄い酸化膜が拡散窓中に形成されるが、スライトエッチで除去可能である。酸化膜 8 6 の上に図 7 (o) に示すように、スパッタリング法又は電子ビーム (E B) 真空蒸着法等によりアルミニウム合金膜 1 0 を形成する。この上にレジスト膜を塗布し、フォトリソグラフィ技術を用いて、レジスト膜をパターニングしメタライゼーション用マスクを形成する。このメタライゼーション用マスクを用いて、アルミニウム合金膜 1 0 を R I E により選択的にエッチングする。この結果、アルミニウム合金膜 1 0 が図 7 (p) に示すようにパターニングされ、接続配線 1 2、第 1 エミッタ配線 1 1、第 1 ベース配線 1 4、第 2 エミッタ配線 4 2、第 2 コレクタ配線 4 1 が形成される。その後、電極配線のパターニングに用いたフォトリソレジスト膜を除去する。そして、図示を省略しているが、機械的損傷防止と、水分や不純物の浸入の防止を目的とした膜厚 6 0 0 n m ~ 1 . 5 μ m 程度のパッシベーション膜を第 1 エミッタ配線 1 1、第 1 ベース配線 1 4、接続配線 1 2、第 2 エミッタ配線 4 2、第 2 コレクタ配線 4 1 上に C V D 法により積層する。パッシベーション膜には、酸化膜、P S G 膜、B P S G 膜や窒化膜 (S i ₃ N₄ 膜)

、あるいはこれらの複合膜、更にはポリイミド膜などが利用される。

【 0 0 3 2 】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法によれば、先に形成した勾配ベース領域 5 は第 1 エミッタ領域 6 よりも深くドライブインされることから、勾配ベース領域 5 は第 1 エミッタ領域 6 を隣接して包囲するように形成される。そして、勾配ベース領域 5 と第 1 エミッタ領域 6 とを同一の拡散マスクを使用して自己整合的に D S A によって形成するため、第 1 エミッタ領域 6 の縁部からの勾配ベース領域 5 の広がり幅は等しく、かつ不純物プロファイルの勾配も等しくすることが出来る。このため、従来の半導体装置の製造方法に比べ簡略なプロセスで高集積化された B J T の形成が可能になり、大幅なコストダウンが実現できる。

【 0 0 3 3 】

(その他の実施の形態)

本発明は上記のような実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び製造工程技術が明らかとなるう。

【 0 0 3 4 】

例えば、上記実施の形態の説明においては第 1 導電型を p 型、第 2 導電型を n 型として説明したが、第 1 導電型を n 型、第 2 導電型を p 型としても良いことは勿論である。

【 0 0 3 5 】

また、素子分離領域 4 9 を溝面絶縁膜 9 2 及び埋込絶縁膜 9 1 からなる絶縁分離構造で説明したが、接合分離構造でも構わない。

【 0 0 3 6 】

また本発明は、パワー I C に限定されるものではなく、小信号用の論理集積回路でも構わない。そして、I I L 論理回路等の場合のように、対象とする集積回路の回路構成に応じて素子分離領域を省略しても良い。

【 0 0 3 7 】

更に集積化する回路構成に応じて、第 1 埋込領域 2 2 及び第 2 埋込領域 2 3 は共有して形成されても構わないし、同一半導体基板 1 上にそれぞれ別々に形成されても構わない。また、第 1 プラグ領域 4 及び第 2 プラグ領域 4 3 は共有して形成されても構わないし、同一半導体基板 1 上にそれぞれ別々に形成されても構わない。

【 0 0 3 8 】

更に、上記の実施の形態の説明においては、Si 基板を用いる場合を説明したが、炭化珪素 (SiC)、ガリウム砒素 (GaAs)、インジウムリン (InP) 等の他の半導体材料を用いても構わないことは勿論である。

【 0 0 3 9 】

このように本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。従って、本発明の技術的な範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。

【 0 0 4 0 】

【発明の効果】

本発明によれば、従来の横型 BJT に比較してベース幅 W_b を狭くして所望のコレクターエミッタ間耐圧 (BV_{ceo}) を得ることが出来る。

【 0 0 4 1 】

また、本発明によれば、横型 BJT の占有スペースを減少することが出来、半導体装置の集積度を高めることが出来る。

【 0 0 4 2 】

更に、本発明によれば、集積化された BJT の電流増幅率を向上させることが出来る。

【 0 0 4 3 】

更に、本発明によれば、従来の半導体装置の製造方法に比べ簡略なプロセスで高集積化された BJT の形成が可能になり、大幅なコストダウンが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 (a) は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の一部を示す等価回路図

で、図 1 (b) は、図 1 (a) に対応した半導体装置の平面図である。

【図 2】

図 2 (a) は、図 1 (b) の A - A 方向に沿った断面図で、図 2 (b) は、図 1 (b) の B - B 方向に沿った断面図である。

【図 3】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す工程断面図である（その 1）。

【図 4】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す工程断面図である（その 2）。

【図 5】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す工程断面図である（その 3）。

【図 6】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す工程断面図である（その 4）。

【図 7】

本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す工程断面図である（その 5）。

【図 8】

図 8 (a) は、従来の横型 p n p トランジスタを有する半導体装置の断面図で、図 8 (b) は、対応する平面図である。

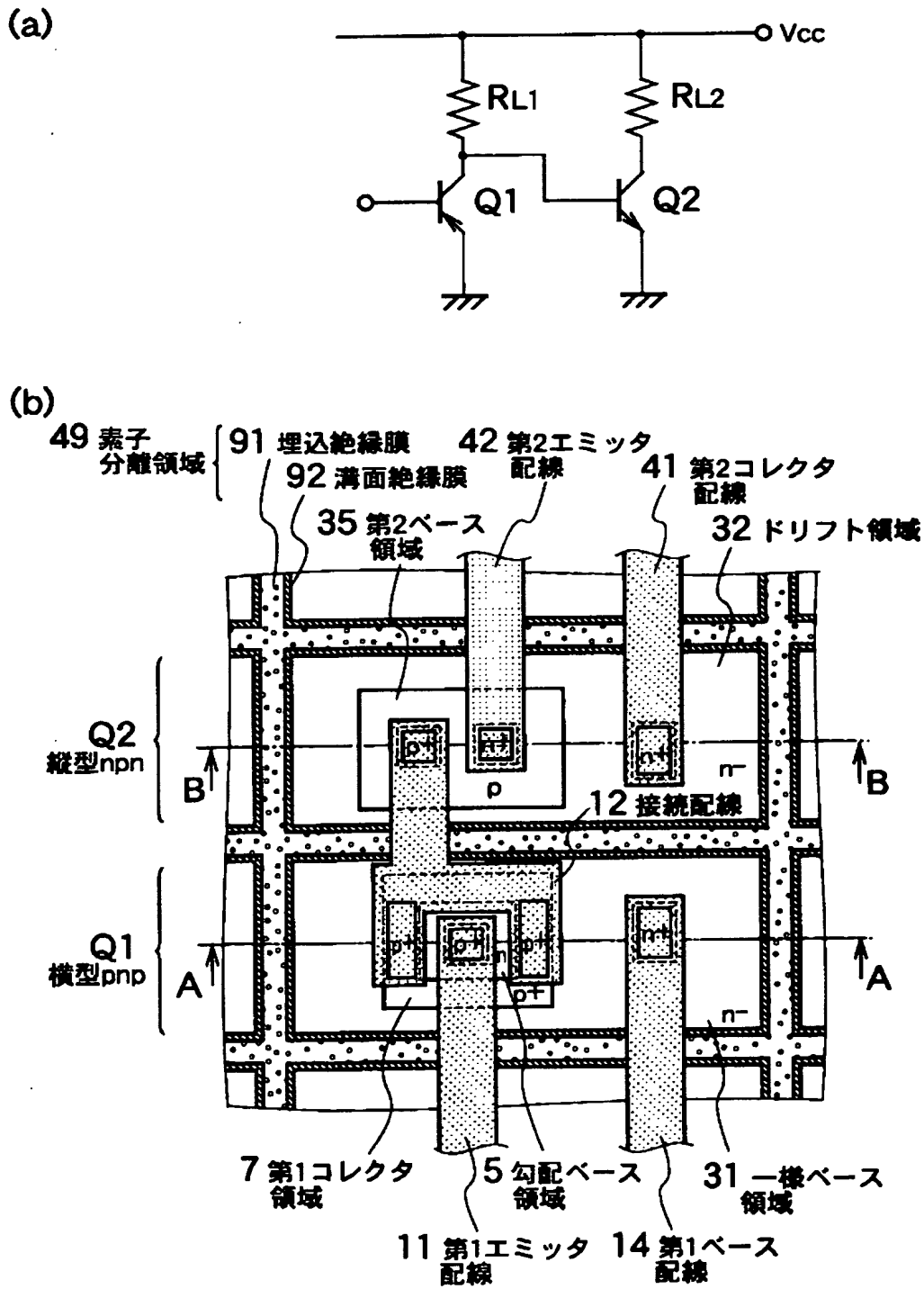
【符号の簡単な説明】

- 1 半導体基板
- 3, 33 第 1 ベース領域
- 4 第 1 プラグ
- 5 勾配ベース領域
- 6 第 1 エミッタ領域
- 7 第 1 コレクタ領域

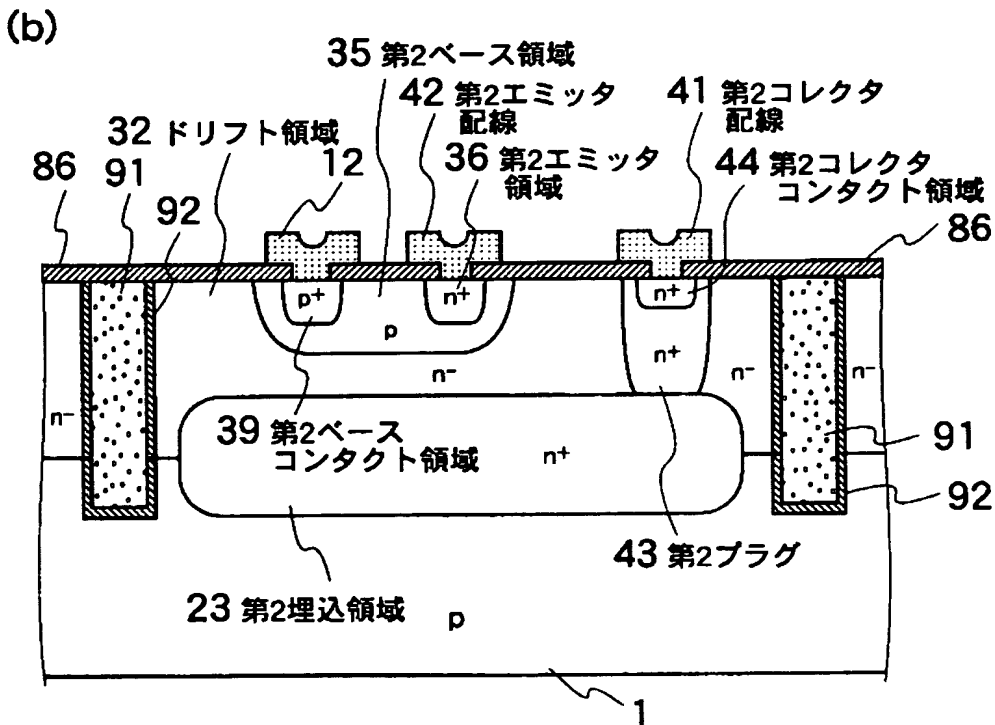
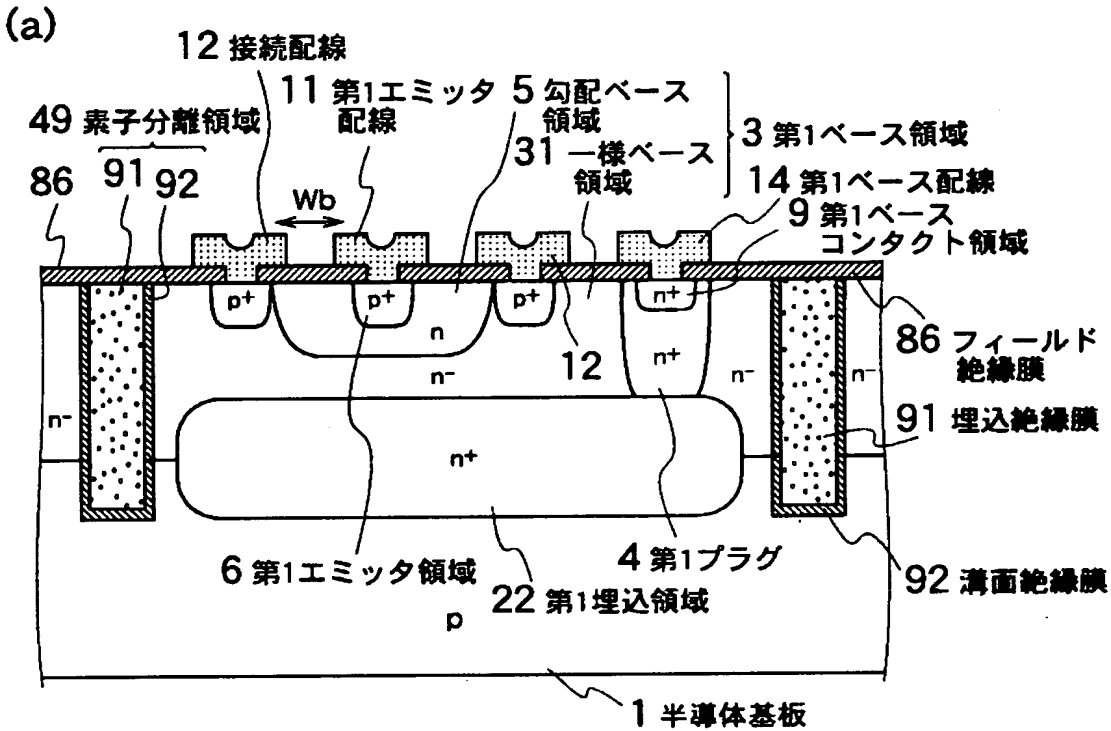
- 9 第 1 ベースコンタクト領域
 - 1 0 アルミニウム合金膜
 - 1 1 第 1 エミッタ配線
 - 1 2 接続配線
 - 1 4 第 1 ベース配線
 - 2 1 n^+ 拡散領域
 - 2 2 第 1 埋込領域
 - 2 3 第 2 埋込領域
 - 3 1 一様ベース領域
 - 3 2 ドリフト領域
 - 3 4 エピタキシャル成長層
 - 3 5 第 2 ベース領域
 - 3 6 第 2 エミッタ領域
 - 3 9 第 2 ベースコンタクト領域
 - 4 1 第 2 コレクタ配線
 - 4 2 第 2 エミッタ配線
 - 4 3 第 2 プラグ
 - 4 4 第 2 コレクタコンタクト領域
 - 4 9 素子分離領域
 - 5 1, 5 2 レジスト膜
 - 7 1 素子分離溝
 - 8 1, 8 2 酸化膜
 - 8 6 フィールド絶縁膜
 - 9 1 埋込絶縁膜
 - 9 2 溝面絶縁膜

【書類名】 図面

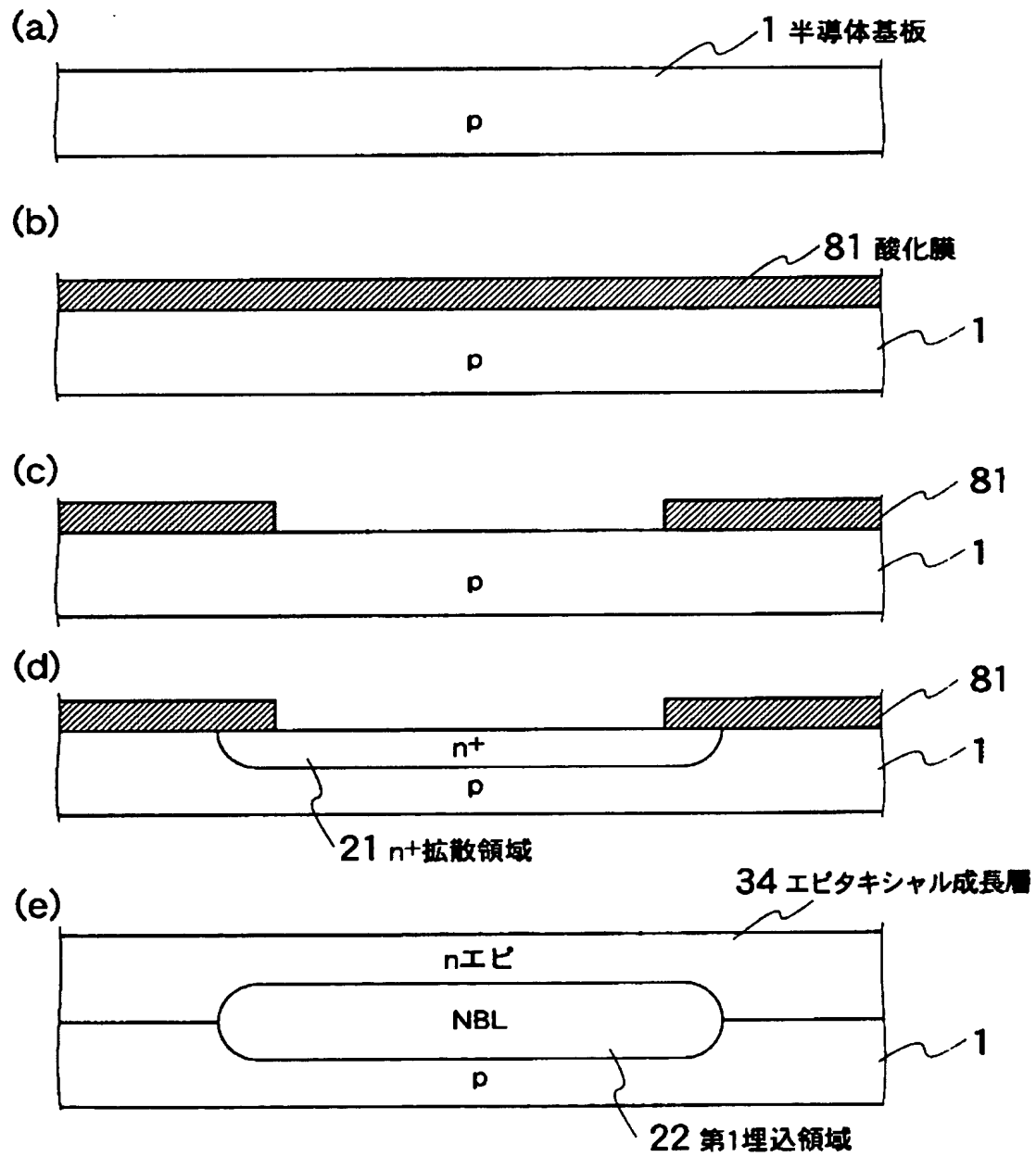
【図 1】



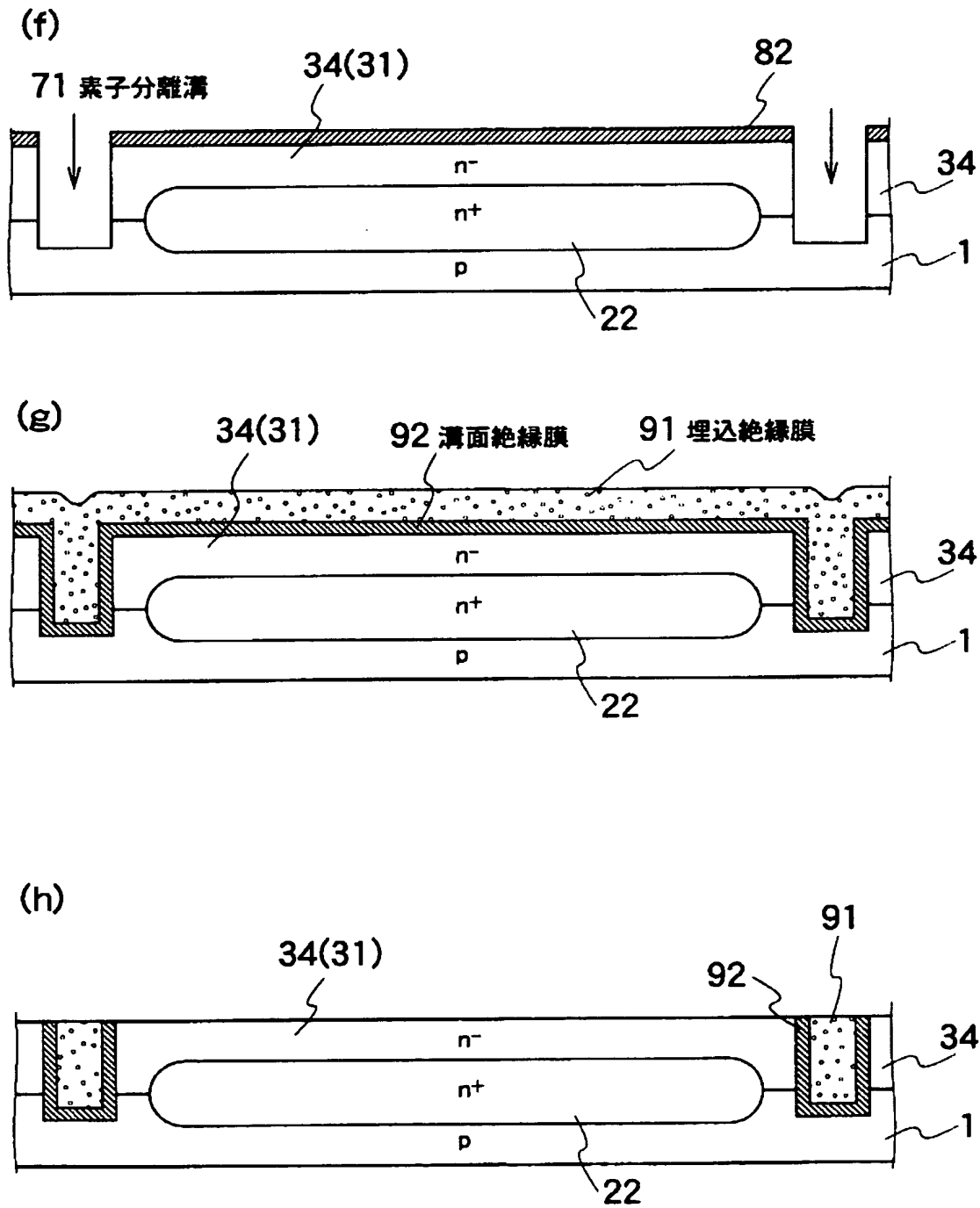
【図2】



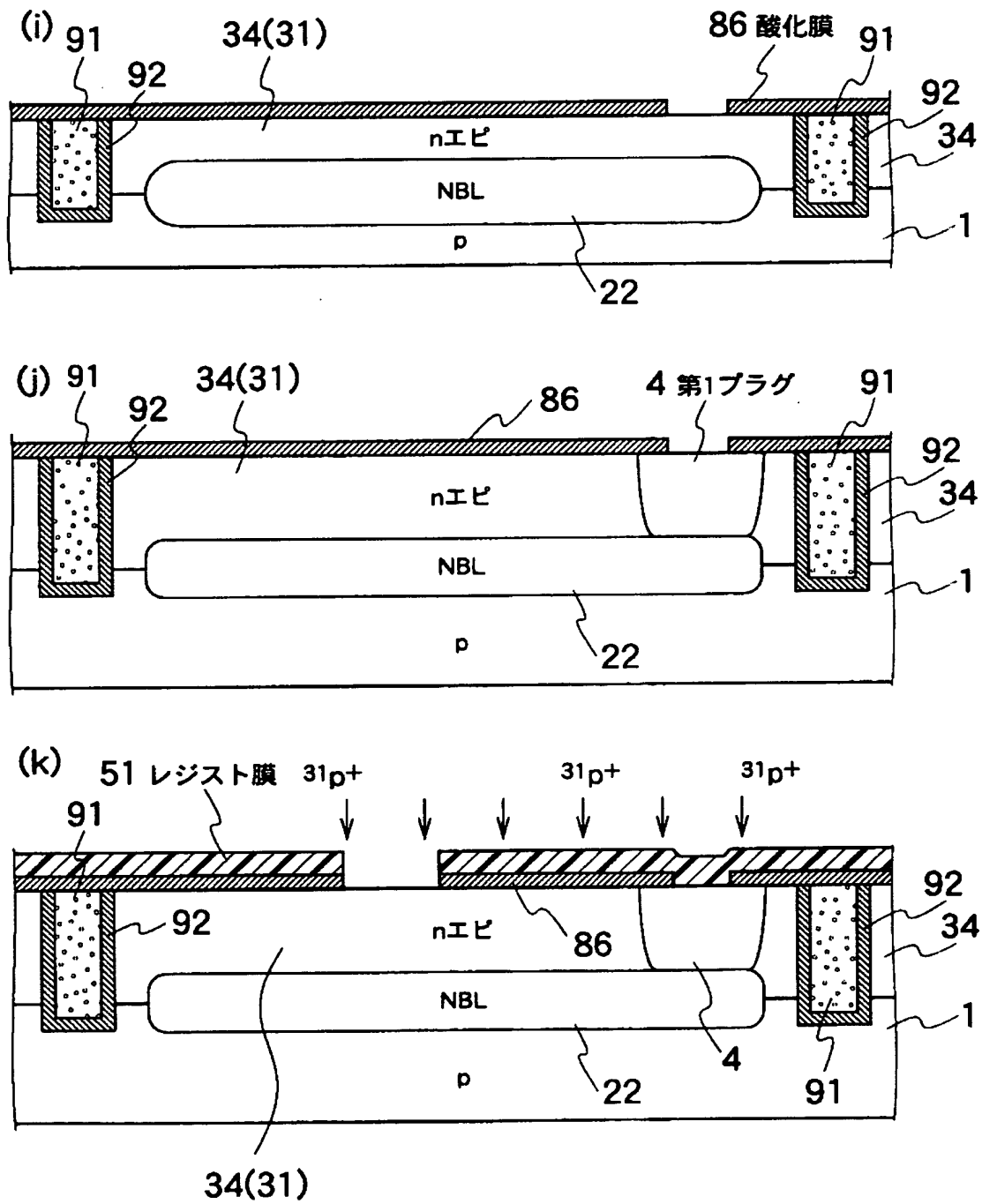
【図 3】



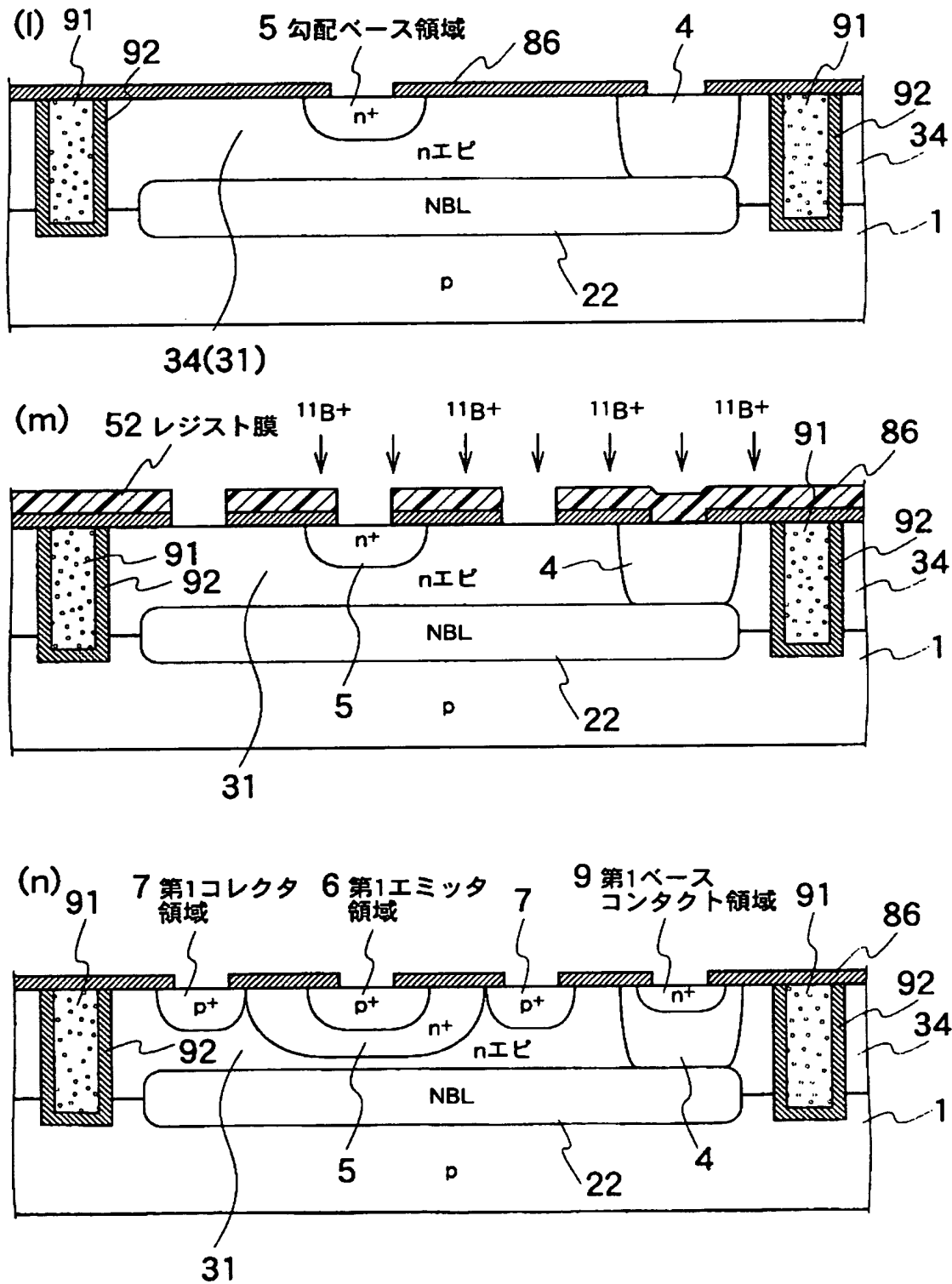
【図 4】



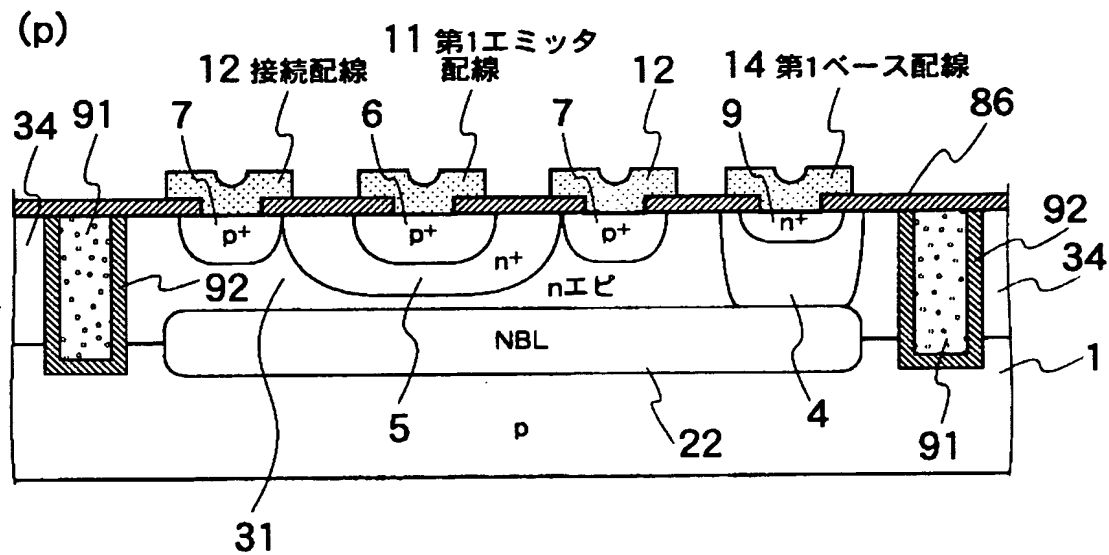
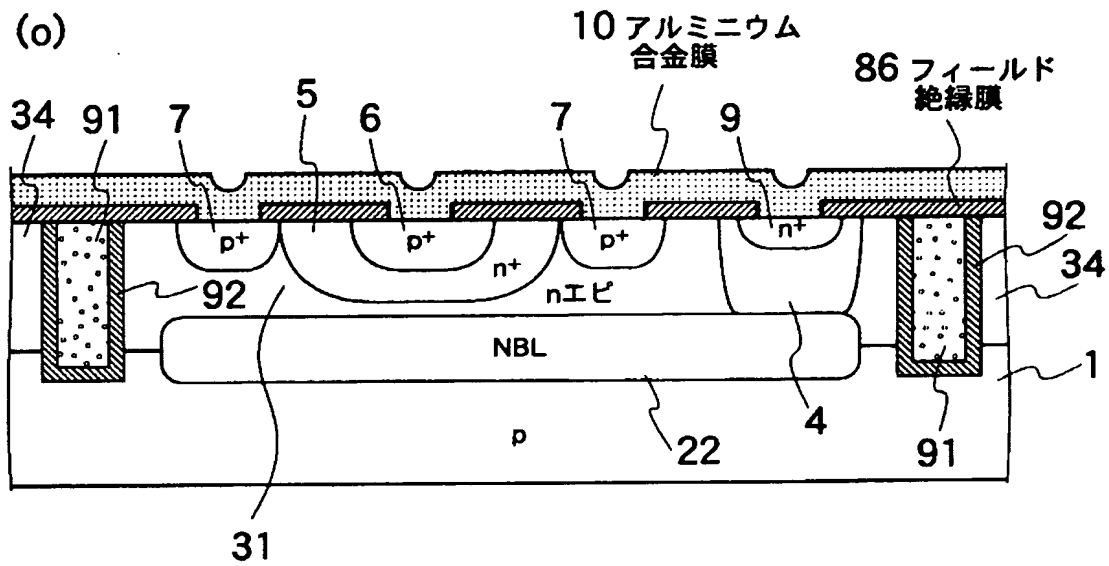
【図 5】



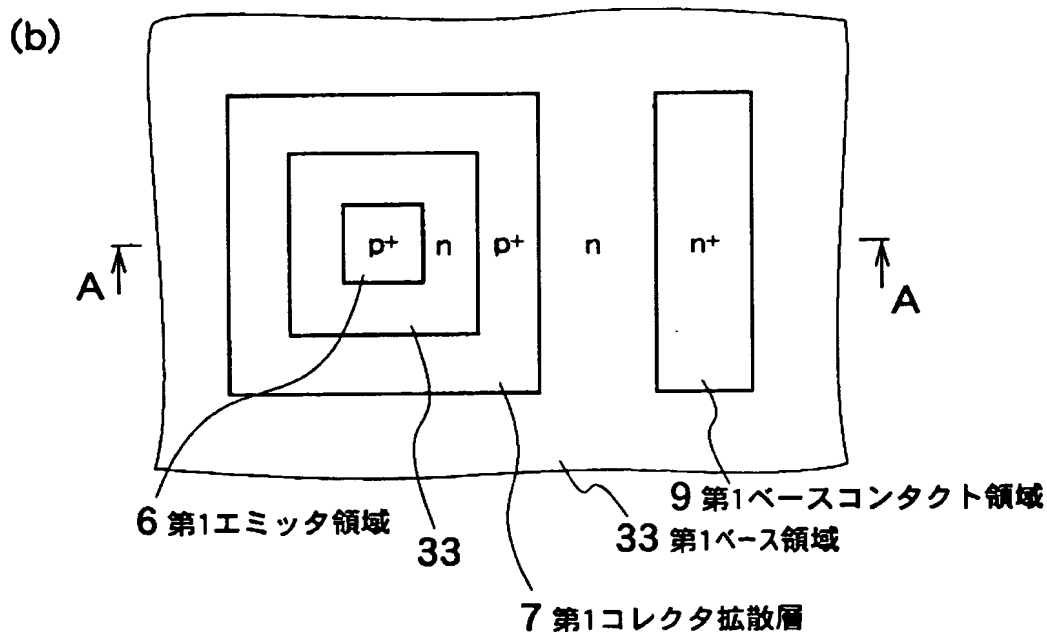
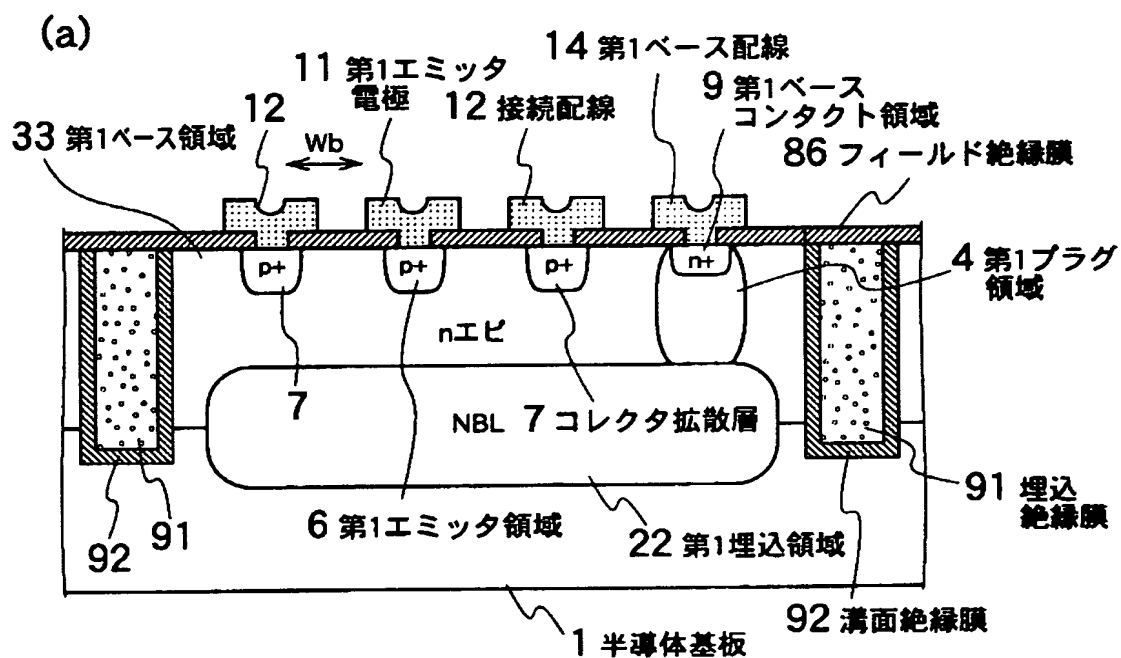
【図6】



【図 7】



【图 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電力用トランジスタと制御回路とを同一半導体チップに搭載したパワー I C の集積度を向上させる。

【解決手段】 横型 p n p トランジスタは、半導体基板 1、半導体基板 1 上の第 1 埋込領域 2 2、一様ベース領域 3 1、第 1 エミッタ領域 6 及び第 1 コレクタ領域 7 を有する。第 1 エミッタ領域 6 の底部及び側面を包囲するように n 型の勾配ベース領域 5 が形成されている。また、同一基板上の別の領域においては、第 2 埋込領域 2 3、ドリフト領域 3 2、第 2 エミッタ領域 3 6、第 2 ベース領域 3 5 を有する縦型 n p n トランジスタが集積化されている。第 1 エミッタ領域 6 を包囲するように勾配ベース領域 5 を形成することにより、ベース幅 W_b を狭くし、半導体装置の集積度を高めることが出来る。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000106276]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	埼玉県新座市北野3丁目6番3号
氏 名	サンケン電気株式会社